

概述

HY2120 采用 SOT23-6L 的封装形式，HY2120 是一款基于 CMOS 的双节可充电锂电池保护电路，它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于一身。

特点

- 两节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
- 高精度的保护电压（过充/过放）检测
- 高精度过电流充电/放电保护检测
- 低供电电流
- 在低功耗模式，不接充电器情况下，可自动恢复状态
- 电池短路保护
- 平芯微产品有多种检测电压和延迟时间
- 支持 0V 电池充电功能
- 极少的外围元器件
- SOT23-6 封装

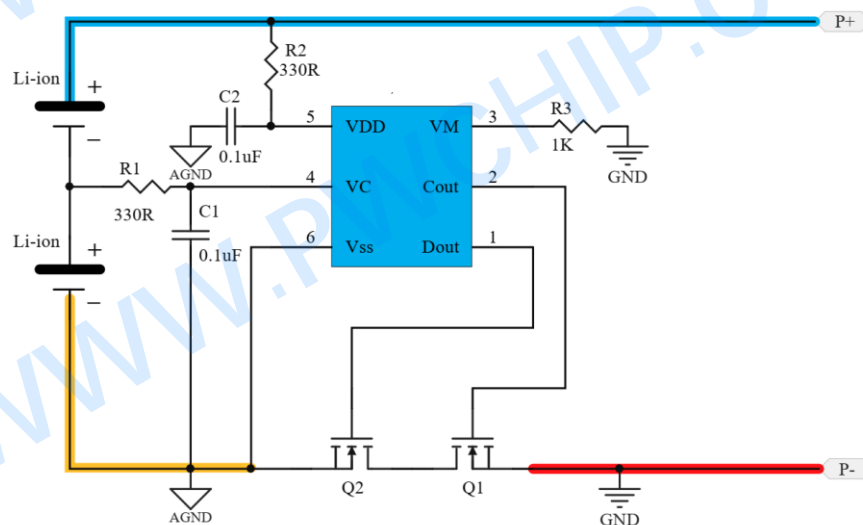
技术支持/代理商：深圳夸克微

郑R 13528458039

应用

- 两节锂电池的充电、放电保护电路
- 电话机电池或其它两节锂电池高精度保护器

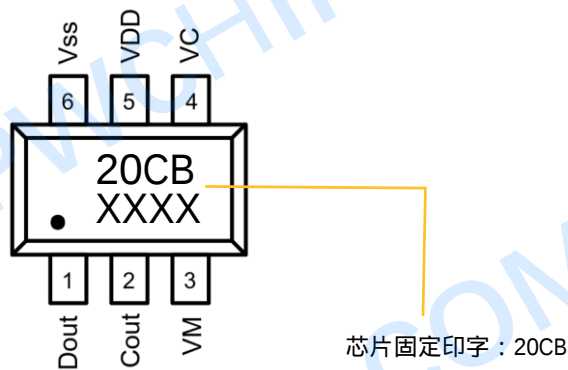
典型应用电路



R1 和 R2 用于稳定芯片的供电电压，推荐分别使用 330Ω 的电阻。如果 R1 和 R2 太大，芯片的导通电流会导致检测电压上升，使各检测阈值与电池实际电压偏差增加；同时，如果充电器接反，可能会使 HY2120 电路的 VDD 端与 VSS 端电压超过极限值，导致电路损坏，因此 R1 和 R2 也不宜太小，一般控制在 100Ω 至 470Ω 之间。在充电器反接或连接充电电压高于极限值时，R3 起限制电流的作用。如果 R3 太小，由于充电器的反接在芯片内部流入容许功耗以上的电流，有导致芯片损坏的危险。R3 连接过大电阻，当连接高电压充电器时，有可能导致不能切断充电电流的情况发生。因此 R3 应控制在 1kΩ 至 4kΩ 之间。C1 和 C2 有稳定 VDD 电压的作用，推荐选用大于或等于 0.1μF 的电容器。

Q1 和 Q2 选型参考：PW8206A6S (SOT23-6 封装)，PW4406A (SOP8 封装)，PW20N03 / PW50N03 (TO252 封装)。

引脚描述

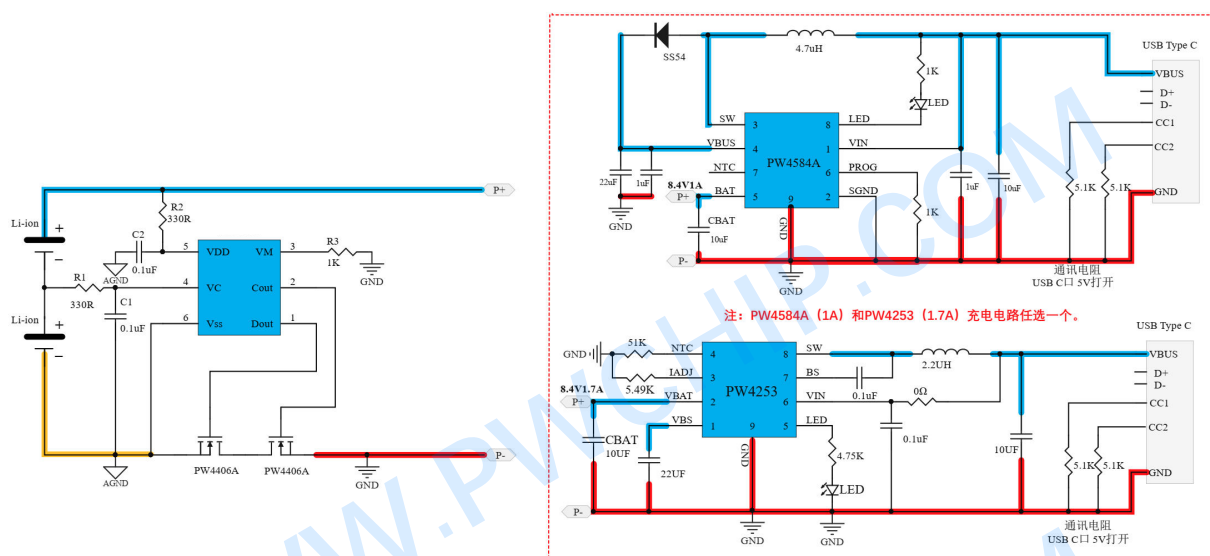


编号	引脚名称	引脚功能
1	DOUT	放电控制输出端，与外部放电控制 N-MOSFET 管 Q2 的栅极 (G 极) 相连。
2	COUT	充电控制输出端，与外部充电控制 N-MOSFET 管 Q1 的栅极 (G 极) 相连。
3	VM	充/放电电流检测输入端，该引脚通过一个限流电阻 (一般为 1kΩ) 与外部充电控制 N-MOSFET 管 Q1 的源极 (S 极) 相连，从而检测充/放电电流在两个 N-MOSFET 管 (Q1 和 Q2) 上形成的压降。
4	VC	两节电池的中间输入端，与两节电池的连接点相连。
5	VDD	电源输入端，与供电电源 (电池) 的正极连接，该引脚需用一个 0.1μF 的瓷片电容去藕。
6	VSS	电源接地端，与供电电源 (电池) 的负极相连。

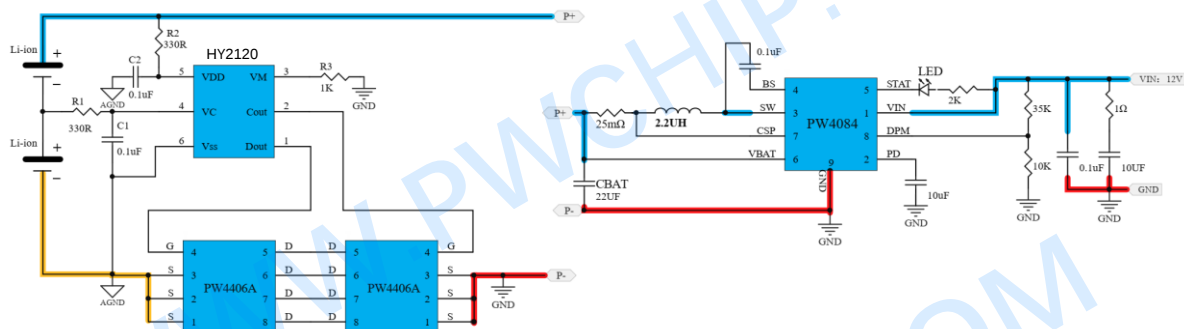
阈值和延迟时间

参数名称	HY2120-CB	精度范围
过电压充电保护阈值 VOCUTYP/ VOCDTYP	4.280V	±25mV
过电压充电恢复阈值 VOCRUTYP/ VOCRDTYP	4.080V	±50mV
过电压放电保护阈值 VODUTYP/ VODDTYP	2.900V	±80mV
过电压放电恢复阈值 VODRUTYP/ VODRDTYP	3.000V	±100mV
过电流放电保护阈值 VEDITYP	0.200V	±30mV
过电流充电保护阈值 VECITYP	-0.200V	±30mV
过电压充电保护延迟时间 tOCTYP	1.0s	±30%
过电压放电保护延迟时间 tODTYP	128ms	±30%
过电流放电保护延迟时间 tEDITYP	12ms	±30%
过电流充电保护延迟时间 tECITYP	8ms	±30%
0V 充电功能	允许	
过放后自恢复	允许	

参考电路图 1：HY2120 与升压充电电路 PW4584A/PW4253 搭配电路



参考电路图 2：HY2120 与降压充电电路 PW4084 搭配电路

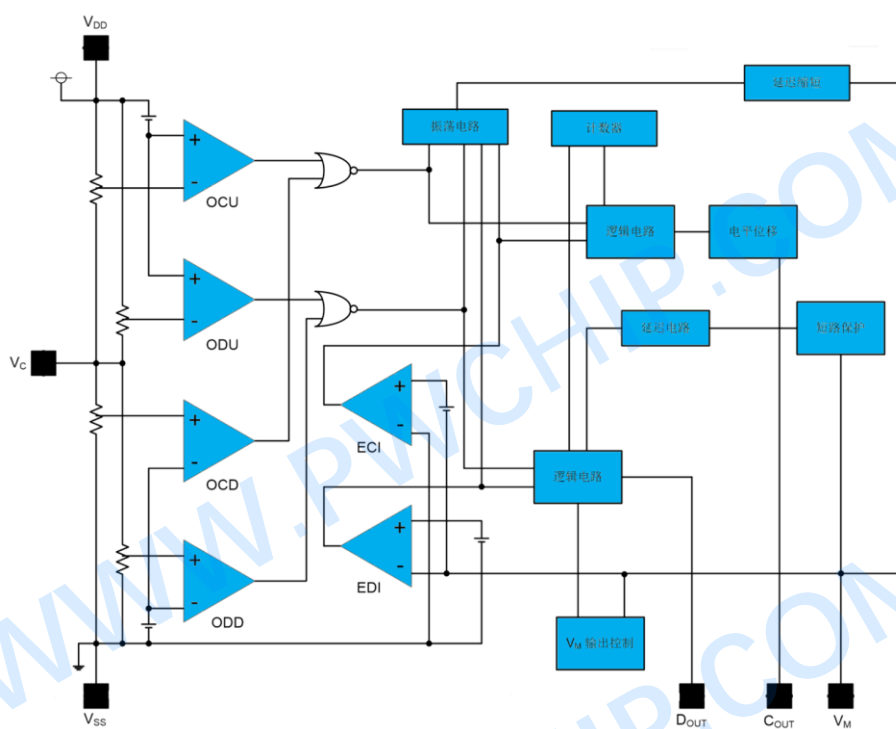


极限参数

名称	范围	单位
供电电源 VDD	-0.3~+12	V
VM、COUT 端允许输入电压	VDD-30~VDD+0.3	V
VC、DOUT 端允许输入电压	-0.3~VDD+0.3	V
工作温度 TA	-40~+85	°C
结温	150	°C
贮存温度	-65 ~150	°C
功耗 PD (TA=25°C) 热阻 $\theta_{JA}=200^{\circ}\text{C}/\text{W}$	625	mW
焊接温度 (锡焊, 10 秒)	260	°C

注：超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。以上给出的仅仅是极限范围，在这样的极限条件下工作，器件的技术指标将得不到保证，长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。

功能框图



电气参数

(除非特别注明, 典型值的测试条件为: TA=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电电源	VDD		1.5		10	V
0V 电池充电开启电压	V0CHA	VBATU/D=0V, 升高 (VDD-VM)	1.2			V
过电压充电保护阈值	VOCU/D		VOCUTYP/ VOCDTYP- 0.025	VOCUTYP/ VOCDTYP	VOCUTYP/ VOCDTYP+0.0 25	V
过电压充电恢复阈值	VOCRU/D		VOCRUTYP/ VOCRDTYP- 0.050	VOCRUTYP/ VOCRDTYP	VOCRUTYP/ VOCRDTYP+0. 050	V
过电压充电保护延迟时间	TOC	VBATU/D=3.5V → 4.5V, VBATD/U=3.5V	0.7	1	1.3	s
过电压充电恢复延迟时间	TOCR	VBATU/D=4.5V → 3.5V, VBATD/U=3.5V	11	16	21	ms
过电压放电保护阈值	VODU/D		VODUTYP/ VODDTYP- 0.08	VODUTYP/ VODDTYP	VODUTYP/ VODDTYP+0.08	V
过电压放电恢复阈值	VODRU/D		VODRUTYP/ VODRDTYP- 0.1	VODRUTYP/ VODRDTYP	VODRUTYP/ VODRDTYP+0.1	V
过电压放电保护延迟时间	TOD	VBATU/D=3.5V → 2.2V, VBATD/U=3.5V	89	128	167	ms
过电压放电恢复延迟时间	TODR	VBATU/D=2.2V → 3.5V, VBATD/U=3.5V	0.7	1.2	1.7	ms
过电流放电保护阈值	VEDI	VBATU=VBATD =3.6V	0.170	0.200	0.230	V
过电流放电保护延迟时间	TEDI	VBATU=VBATD =3.5V; VM=0→0.5V	8	12	16	ms
过电流放电恢复延迟时间	TEDIR	VBATU=VBATD =3.5V; VM=0.5→0V	0.7	1.2	1.7	ms
过电流充电保护阈值	VECI	VBATU=VBATD =3.6V	-0.230	-0.200	-0.170	V
过电流充电保护延迟时间	TECI	VBATU=VBATD =3.5V; VM=0→-0.5V	5	8	11	ms
过电流充电恢复延迟时间	TECIR	VBATU=VBATD =3.5V; VM=-0.5→0V	0.7	1.2	1.7	ms
电池短路保护阈值	VSHORT	VBATU=VBATD =3.5V	0.6	1.0	1.4	V
电池短路保护延迟时间	TSHORT	VBATU=VBATD =3.5V; VM=0→7.0V	150	300	500	us
VM 至 VSS 之间的下	RVMS	VDD=7.0V; VM=1V		10		KΩ

拉电阻						
VM 至 VDD 之间的 上拉电阻	RVMD	VBATU=VBATD =2V, VM=0V		360		KΩ
COUT 输出低电平	VCOL	IO=10uA;VBATU= VBATD =4.5V		0.5	0.7	V
COUT 输出高电平	VCOH	IO=-50uA;VBATU= VBATD =3.9V	7.4	7.6		V
DOUT 输出低电平	VDOL	IO=10uA;VBATU= VBATD =2.0V		0.4	0.6	V
DOUT 输出高电平	VDOH	IO=-50uA;VBATU= VBATD =3.9V	7.4	7.6		V
电源电流	IDD	VBATU=VBATD =3.9V,VM=0V		4.5	8.0	μA
待机电流	IS	VBATU=VBATD =2.0V		2.1		μA

功能描述

HY2120 是一款高精度的两节锂电池保护电路。正常状态下，可以对电池进行充电或放电。HY2120 一直检测两个电池电压以及 VM 端和 VSS 端的电压差，当某个电压超出正常阈值范围时，充电控制端 COUT 或放电控制端 DOUT 由高电平转为低电平，从而使外接充电/放电控制 N-MOSFET 管 Q1 或 Q2 关闭，充电/放电回路被“切断”，即 HY2120 进入相应的保护状态。HY2120 支持以下 4 种保护模式。

- 过电压充电保护状态 (OC)
- 过电压放电保护 (OD)/ 低功耗状态 (PDWN)
- 过电流放电保护(EDI)/ 电池短路保护状态 (Short)
- 过电流充电保护(ECI)

当 HY2120 在某一保护状态时，如果满足一定条件，即恢复到正常状态。下面对各状态进行详细描述。

正常状态

在正常状态下，HY2120 由电池供电。当两节电池电压 (VBATU/VBATD) 都在过电压充电保护阈值 (VOCU/D) 和过电压放电保护阈值 (VODU/D) 之间，且其 VM 检测端电压在过电流充电保护阈值 (VECI) 和过电流放电保护阈值 (VEDI) 之间，此时 HY2120 的 COUT 端和 DOUT 端都输出高电平，分别使外接充电控制 N-MOSFET 管 Q1 和放电控制 N-MOSFET 管 Q2 导通。这时，既可以使用充电器对电池充电，也可以通过负载使电池放电。

过电压充电保护状态 (OC)

• 保护条件

正常状态下，对电池进行充电，如果使任何一个电池电压 (VBATU/VBATD) 超过过电压充电保护阈值 (VOCU/D)，且持续时间超过过电压充电保护延迟时间 (tOC)，则 HY2120 将使充电控制端 COUT 由高电平转为 VM 端电平 (低电平)，从而使外接充电控制 N-MOSFET 管 Q1 关闭，充电回路被“切断”，即 HY2120 进入过电压充电保护状态。

• 恢复条件

有以下两种条件可以使 HY2120 从过电压充电保护状态恢复到正常状态：

- 1) 电池由于“自放电”使电池电压 (VBATU/VBATD) 低于过电压充电恢复阈值 (VOCRU/D)，VM 端电压低于过电流放电保护阈值 (VEDI)，且持续时间超过过电压充电恢复延迟时间 (tOCR)；
- 2) 通过负载使电池放电（注意，此时虽然 Q1 关闭，但由于其体内二极管的存在，使放电回路仍然存在），当电池电压 (VBATU/VBATD) 低于过电压充电保护阈值 (VOCU/D)，VM 端电压高于过电流放电保护阈值 (VEDI)，且持续时间超过过电压充电恢复延迟时间 (tOCR)。（在 Q1 导通以前，VM 端电压将比 VSS 端高一个二极管的导通压降）。HY2120 恢复到正常状态以后，充电控制端 COUT 将输出高电平，使外接充电控制 N-MOSFET 管 Q1 回到导通状态。

过电压放电保护/低功耗状态 (OD/PDWN)

• 保护条件

正常状态下，如果电池放电使任何一个电池电压 (VBATU/VBATD) 低于过电压放电保护阈值 (VODU/D)，且持续时间超过过电压放电保护延迟时间 (tOD)，则 HY2120 将使放电控制端 DOUT 由高电平转为 VSS 端电平 (低电平)，从而使外接放电控制 N-MOSFET 管 Q2 关闭，

放电回路被“切断”，即 HY2120 进入过电压放电保护状态。同时，VM 端电压将通过内部电阻 RVMD 被上拉到 VDD。

在过电压放电保护状态下，VM 端（亦即 VDD 端）电压总是高于电池短路保护阈值 (VSHORT)，满足此条件后，电路会进入“省电”的低功耗模式。此时，VDD 端的电流将低于 2.1 μ A。

• 恢复条件

对于处在低功耗模式下电路，如果对电池进行充电（同样，由于 Q2 体内二极管的存在，此时的充电回路也是存在的），使 VM 端电压低于电池短路保护阈值 (VSHORT)，则 HY2120 将恢复到过电压放电保护状态，此时，放电控制端 DOUT 仍为低电平，Q2 还是关闭的。如果此时停止充电，由于 VM 端仍被 RVMD 上拉到 VDD，大于电池短路保护阈值 (VSHORT)，因此 HY2120 又将回到低功耗模式；只有继续对电池充电，当两个电池电压 (VBATU/VBATD) 都大于过电压放电保护阈值 (VODU/D) 时，HY2120 才可从过电压放电保护状态恢复到正常状态。如果不使用充电器，由于电池去掉负载后的“自升压”，可能会使两个电池电压 (VBATU/VBATD) 超过过电压放电恢复阈值 (VODRU/D)，且持续时间超过过电压放电恢复延迟时间 (tODR)，此时 HY2120 也将从过电压放电保护状态或低功耗模式恢复到正常状态。

HY2120 恢复到正常状态以后，放电控制端 DOUT 将输出高电平，使外接放电控制 N-MOSFET 管 Q2 回到导通状态。

过电流放电/电池短路保护状态(EDI)

• 保护条件

正常状态下，HY2120 通过负载对电池放电，VM 端电压将随放电电流的增加而升高。如果放电电流增加使 VM 端电压超过过电流放电保护阈值 (VEDI)，低于电池短路保护阈值 (VSHORT)，且持续时间超过过电流放电保护延迟时间 (tEDI)，则 HY2120 进入过电流放电保护状态；如果放电电流进一步增加使 VM 端电压超过电池短路保护阈值 (VSHORT)，且持续时间超过短路延迟时间 tSHORT)，则 HY2120 进入电池短路保护状态。

HY2120 处于过电流放电/电池短路保护状态时，DOUT 端将由高电平转为 VSS 端电平，从而使外接放电控制 N-MOSFET 管 Q2 关闭，放电回路被“切断”；同时，VM 端将通过内部电阻 RVMS 连接到 VSS，放电负载取消后，VM 端电平即变为 VSS 端电平。

• 恢复条件

在过电流放电/电池短路保护状态下，当 VM 端电压由高降低至低于过电流放电保护阈值 (VEDI)，且持续时间超过过电流放电恢复延迟时间 (tEDIR)，则 HY2120 可恢复到正常状态。因此，在过电流放电/电池短路保护状态下，当所有的放电负载取消后，HY2120 即可“自恢复”。

恢复到正常状态以后，放电控制端 DOUT 将输出高电平，使外接放电控制 N-MOSFET 管 Q2 回到导通状态。

过电流充电保护状态(ECI)

• 保护条件

正常状态下，使用充电器对电池进行充电，VM 端电压将随充电电流的增加而降低。如果充电电流增加使 VM 端电压低于过电流充电保护阈值 (VECI)，且持续时间超过过电流充电保护延迟时间 (tECI)，则 HY2120 将使充电控制端 COUT 由高电平转为 VM 端电平（低电平），从而使外接充电控制 N-MOSFET 管 Q1 关闭，充电回路被“切断”，即 HY2120 进入过电流充电保护状态。

- 恢复条件

在过电流充电保护状态，如果取消充电器，则 VM 端电压将会升高，当它大于过电流充电保护阈值 (VECI)，且持续时间超过过电流充电恢复延迟时间 (t_{ECIR})，HY2120 将恢复到正常状态。HY2120 恢复到正常状态以后，充电控制端 COUT 将输出高电平，使外接充电控制 N-MOSFET 管 Q1 回到导通状态。

延迟时间缩短测试功能

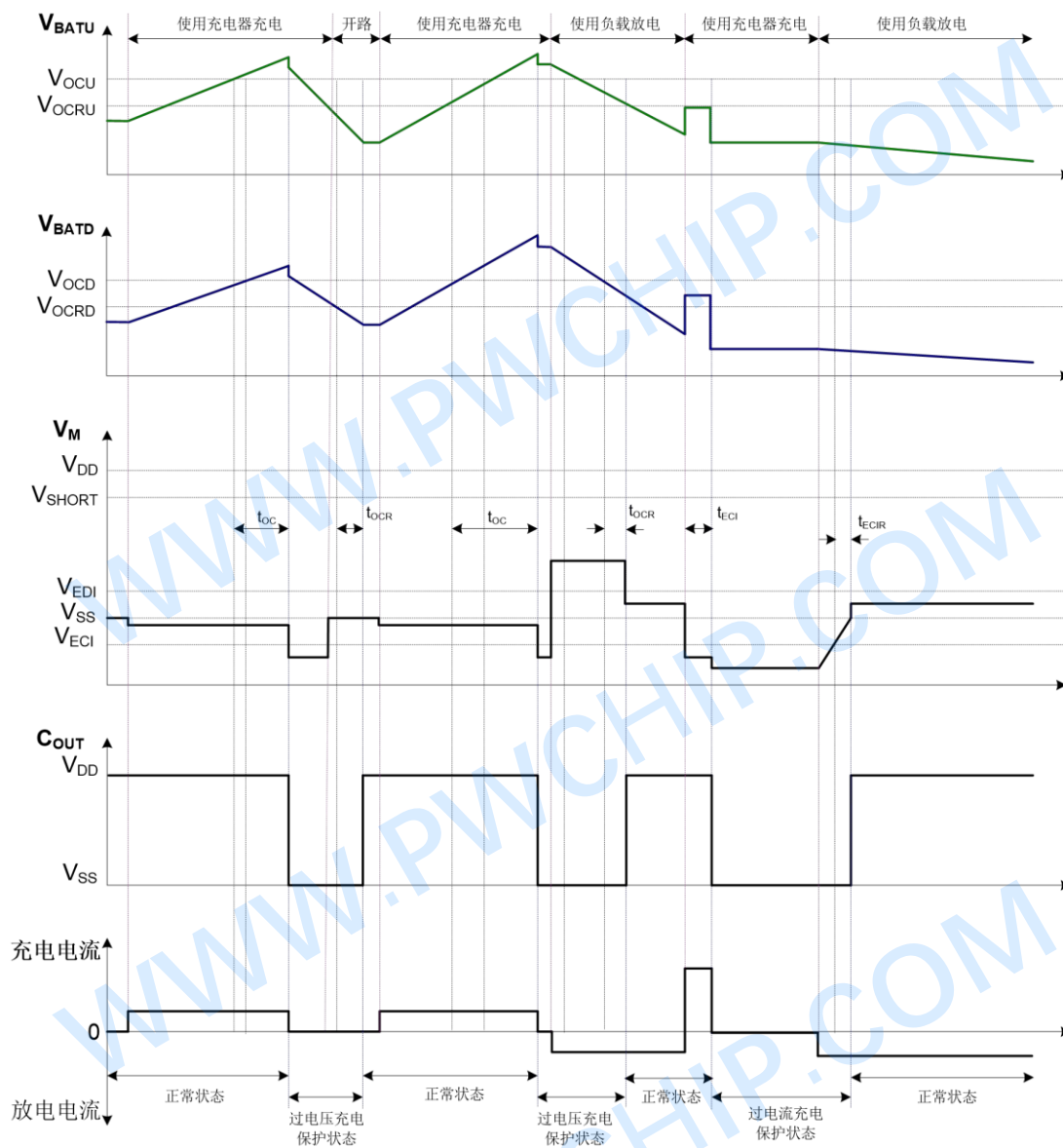
当 VM 小于 -5V，VDD 从 0V 升高至正常值时，芯片将进入快速检测模式，缩短延迟时间，并禁止过电流充电保护功能。过电压充电检测和过电压放电检测延迟时间会缩短到将近 1ms，这可以有效地缩短保护电路 PCB 的检测时间。当 VM 升高至 0V 以上时，芯片将退出快速检测模式。

0V 电池充电

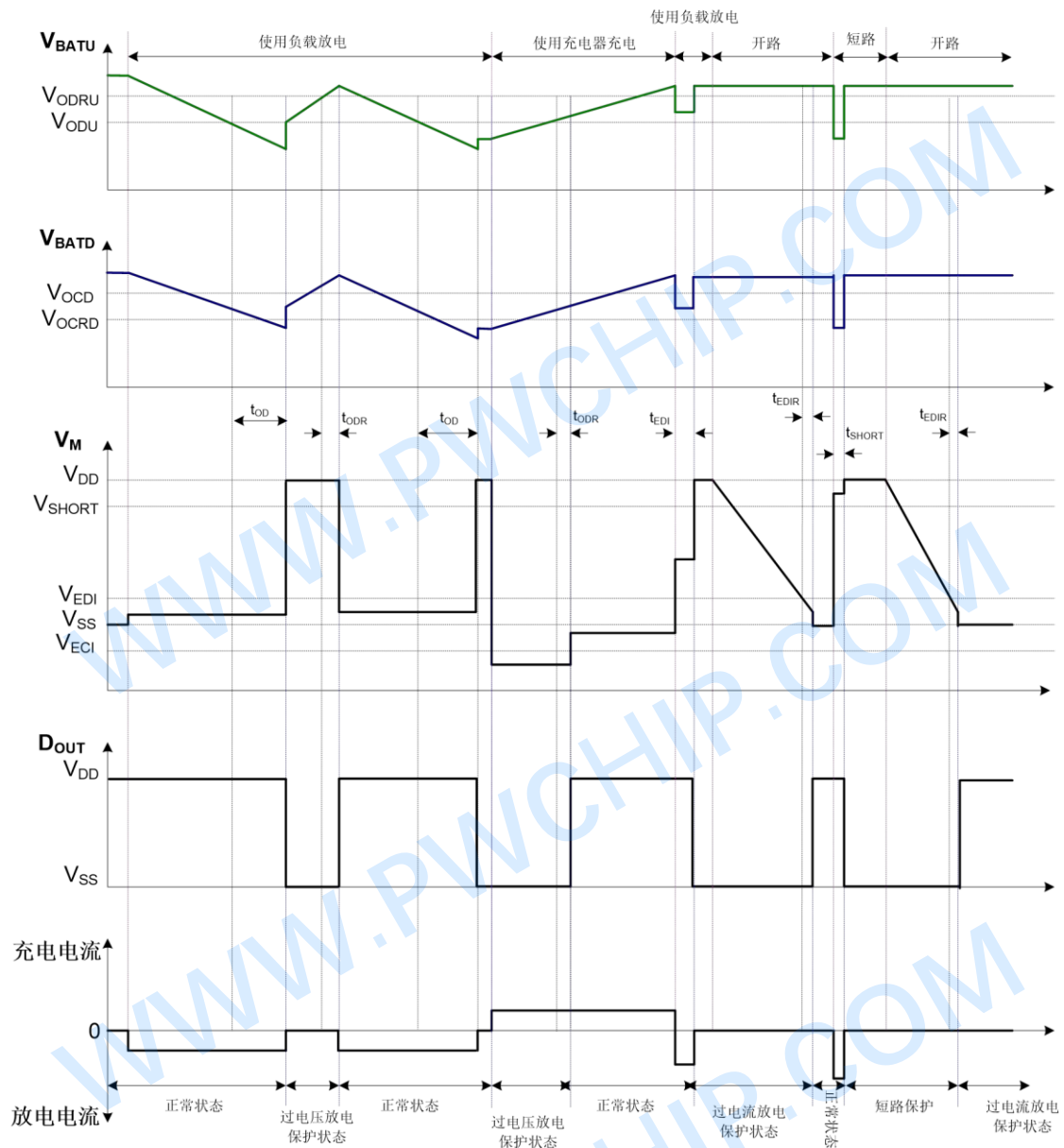
HY2120 的 0V 电池充电功能可以对电压为 0V 的电池进行再充电。如果使用充电器对电池充电，使 VDD 端相对 VM 端的电压大于 0V 充电阈值 (V0CHA) 时，其充电控制端 COUT 将被连接到 VDD 端。若该电压能够使外接充电控制 N-MOSFET 管 Q1 导通，则通过放电控制 N-MOSFET 管 Q2 的体内二极管可以形成一个充电回路，使电池电压升高；当电池电压升高致使 VDD 端电压超过过电压放电保护阈值 (VODU/D) 时，HY2120 将回到正常状态，同时放电控制端 COUT 输出高电平，使外接放电控制 N-MOSFET，Q2 处于导通状态。

时序图

过电压充电保护和过电流充电保护状态

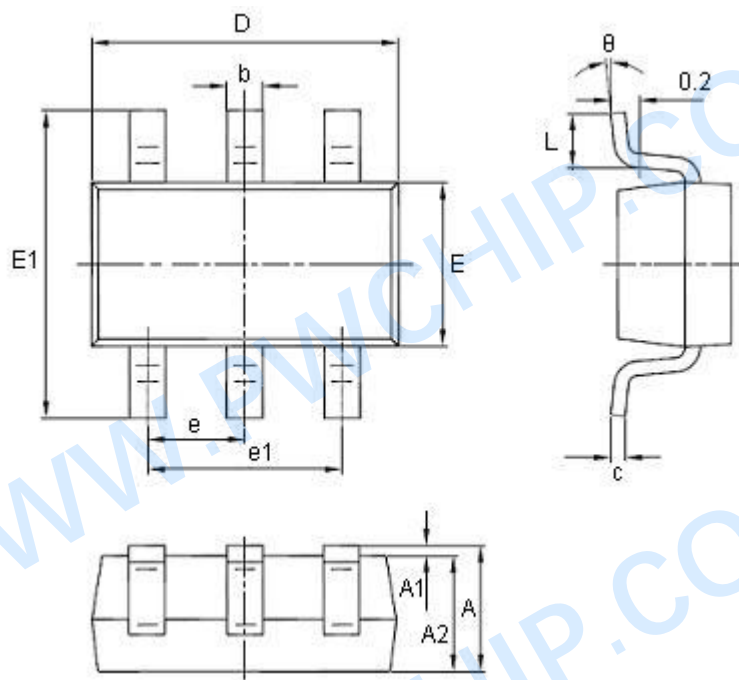


过电压放电/过电流放电/电池短路保护状态



封装尺寸

SOT23-6L



符号	最小值	最大值
A	1.050	1.250
A1	0.000	0.100
A2	1.050	1.150
b	0.300	0.500
c	0.100	0.200
D	2.280	3.020
E	1.500	1.700
E1	2.650	2.950
e	0.950 (BSC)	
e1	1.800	2.000
L	0.300	0.600
θ	0°	8°

单位 (mm)

IMPORTANT NOTICE

Wuxi PWChip Semi Technology CO., LTD (PW) reserves the right to make corrections, modifications, enhancements, improvements, and other changes to its products and services at any time and to discontinue any products or services. Customers should obtain the latest relevant information before placing orders and should verify that such information is current and complete.

PW assumes no liability for applications assistance or customer product design. Customers are responsible for their products and applications using PW components.

PW products are not authorized for use in safety-critical applications (such as life support devices or systems) where a failure of the PW product would reasonably be expected to affect the safety or effectiveness of that devices or systems.

The information included herein is believed to be accurate and reliable. However, PW assumes no responsibility for its use; nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use.